

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 2 区分
 【発行日】平成 23 年 4 月 28 日 (2011.4.28)

【公開番号】特開 2009-258453 (P2009-258453A)
 【公開日】平成 21 年 11 月 5 日 (2009.11.5)
 【年通号数】公開・登録公報 2009-044
 【出願番号】特願 2008-108349 (P2008-108349)
 【国際特許分類】

G 0 3 G 15/20 (2006.01)

【F I】

G 0 3 G 15/20 5 1 5

G 0 3 G 15/20 5 1 0

【手続補正書】

【提出日】平成 23 年 3 月 11 日 (2011.3.11)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基材層と導電層とが形成され、当該導電層が電磁誘導加熱されることで記録材にトナーを定着する定着部材と、

前記定着部材に形成された前記導電層と交差する交流磁界を生成する磁界生成部材と、

前記定着部材を介して前記磁界生成部材と対向して配置され、当該磁界生成部材にて生成された前記交流磁界を内部に誘導しまたは透過する磁界誘導部材とを備え、

前記定着部材の前記基材層と前記磁界誘導部材とは、前記トナーが定着される温度以上であって当該定着部材の耐熱温度以下となる温度範囲内に透磁率変化開始温度が設定されており、当該基材層の厚さは当該トナーが定着される温度での当該基材層の表皮深さよりも小さいことを特徴とする定着装置。

【請求項 2】

前記磁界誘導部材は、前記定着部材と所定の間隙を持って配置されることを特徴とする請求項 1 記載の定着装置。

【請求項 3】

前記磁界誘導部材は、前記磁界生成部材にて生成された前記交流磁界により発生する渦電流を分断する渦電流分断部が形成されたことを特徴とする請求項 2 記載の定着装置。

【請求項 4】

前記磁界誘導部材は、前記定着部材と接触して配置されることを特徴とする請求項 1 記載の定着装置。

【請求項 5】

前記磁界誘導部材は、透磁率変化開始温度が前記定着部材の前記基材層の透磁率変化開始温度よりも低く設定されたことを特徴とする請求項 2 または 3 記載の定着装置。

【請求項 6】

前記磁界誘導部材は、透磁率変化開始温度が前記定着部材の前記基材層の透磁率変化開始温度よりも高く設定されたことを特徴とする請求項 4 記載の定着装置。

【請求項 7】

トナー像を形成するトナー像形成手段と、

前記トナー像形成手段によって形成された前記トナー像を記録材上に転写する転写手段

と、

前記記録材上に転写された前記トナー像を当該記録材に定着する定着手段とを有し、
前記定着手段は、

基材層と導電層とが形成され、当該導電層が電磁誘導加熱されることで記録材にトナーを定着する定着部材と、

前記定着部材に形成された前記導電層と交差する交流磁界を生成する磁界生成部材と、
前記定着部材を介して前記磁界生成部材と対向して配置され、当該磁界生成部材にて生成された前記交流磁界を内部に誘導しまたは透過する磁界誘導部材とを備え、

前記定着部材の前記基材層と前記磁界誘導部材とは、前記トナーが定着される温度以上であって当該定着部材の耐熱温度以下となる温度範囲内に透磁率変化開始温度が設定されており、当該基材層の厚さは当該トナーが定着される温度での当該基材層の表皮深さよりも小さいことを特徴とする画像形成装置。

【請求項 8】

前記定着手段は、前記磁界誘導部材が前記定着部材と所定の間隙を持って配置されることを特徴とする請求項 7 記載の画像形成装置。

【請求項 9】

前記定着手段は、前記磁界誘導部材が前記磁界生成部材にて生成された前記交流磁界により発生する渦電流を分断する渦電流分断部が形成されたことを特徴とする請求項 8 記載の画像形成装置。

【請求項 10】

前記定着手段は、前記磁界誘導部材が前記定着部材と接触して配置されることを特徴とする請求項 7 記載の画像形成装置。

【請求項 11】

前記定着手段は、前記磁界誘導部材の透磁率変化開始温度が前記定着部材の前記基材層の透磁率変化開始温度よりも低く設定されたことを特徴とする請求項 7 記載の画像形成装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0006】

請求項 2 に記載の発明は、前記磁界誘導部材は、前記定着部材と所定の間隙を持って配置されることを特徴とする請求項 1 記載の定着装置である。

請求項 3 に記載の発明は、前記磁界誘導部材は、前記磁界生成部材にて生成された前記交流磁界により発生する渦電流を分断する渦電流分断部が形成されたことを特徴とする請求項 2 記載の定着装置である。

請求項 4 に記載の発明は、前記磁界誘導部材は、前記定着部材と接触して配置されることを特徴とする請求項 1 記載の定着装置である。

請求項 5 に記載の発明は、前記磁界誘導部材は、透磁率変化開始温度が前記定着部材の前記基材層の透磁率変化開始温度よりも低く設定されたことを特徴とする請求項 2 または 3 記載の定着装置である。

請求項 6 に記載の発明は、前記磁界誘導部材は、透磁率変化開始温度が前記定着部材の前記基材層の透磁率変化開始温度よりも高く設定されたことを特徴とする請求項 4 記載の定着装置である。